


	<h2>SI5915DC-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5915DC-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 8V 3.4A 1206-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5915DC-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI5915DC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 8V 3.4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 3.4A, 4.5V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 8V 3.4A 1.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.4A
Basisteilenummer	SI5915

SI5915DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5915DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5915DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5915DC-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5920DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5920DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5915DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 3.4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5915DC</b> VISHAY SI5915DC VISHAY</p>
 <p><b>SI5915DC-T1</b> VISHAY SI5915DC-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI5915DC-T1-E3</b> VISHAY VISHAY 1206-8</p>	 <p><b>SI5915DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 8V 3.4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5915DC-E3</b> VISHAY VISHAY SOP-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5915DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5915DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5915DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5915DC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5915DC-T1-GE3
SI5915DC-T1-GE3 Electronic	SI5915DC-T1-GE3-Komponenten	SI5915DC-T1-GE3-Verteiler	SI5915DC-T1-GE3-Bild	SI5915DC-T1-GE3-Teil
SI5915DC-T1-GE3 Preis	SI5915DC-T1-GE3 Hersteller	SI5915DC-T1-GE3 Bild	SI5915DC-T1-GE3 Aktie	SI5915DC-T1-GE3 Inventar
SI5915DC-T1-GE3 Neu	SI5915DC-T1-GE3 Original	SI5915DC-T1-GE3 garantiert	SI5915DC-T1-GE3 RFQ	SI5915DC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited